

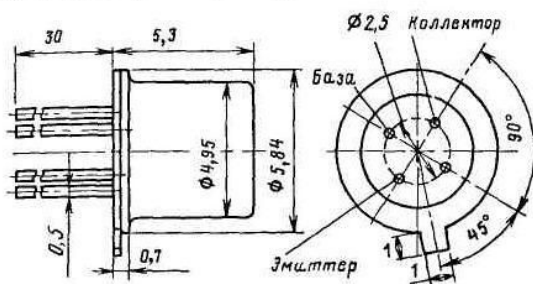
2ТЗ16А, 2ТЗ16Б, 2ТЗ16В, 2ТЗ16Г, 2ТЗ16Д, КТЗ16А, КТЗ16Б, КТЗ16В, КТЗ16Г, КТЗ16Д

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* переключательные маломощные и СВЧ усилительные с ненормированным коэффициентом шума.

Предназначены для переключения (2ТЗ16А, 2ТЗ16Б, 2ТЗ16В, КТЗ16А, КТЗ16Б, КТЗ16В) и усиления сигналов высокой частоты (2ТЗ16Г, 2ТЗ16Д, КТЗ16Г, КТЗ16Д).

Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами.

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. Масса транзистора не более 0,6 г.

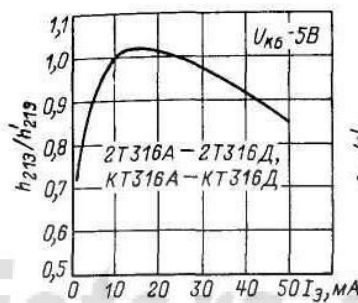


Электрические параметры

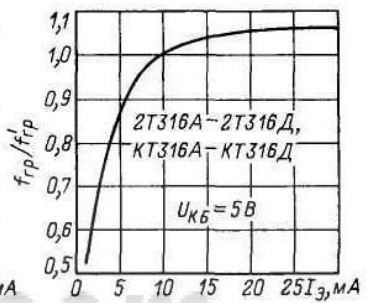
Граничная частота при $U_{КБ} = 5 В, I_Э = 10 мА$:	
2ТЗ16А, КТЗ16А, 2ТЗ16Г, КТЗ16Г не менее	600 МГц
типовое значение	1000* МГц
2ТЗ16Б, КТЗ16Б, 2ТЗ16В, КТЗ16В, 2ТЗ16Д,	
КТЗ16Д не менее	800 МГц
типовое значение	1000* МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КБ} = 5 В, I_Э = 10 мА, f = 10 МГц$:	
2ТЗ16Г, КТЗ16Г, 2ТЗ16Д, КТЗ16Д не более	150 нс
типовое значение	50* нс
Время рассасывания при $I_К = 10 мА, I_{Б1} = 1 мА, I_{Б2} = 1,2 мА, R_К = 75 Ом$:	
2ТЗ16А, КТЗ16А, 2ТЗ16Б, КТЗ16Б не более	10 нс
типовое значение	4* нс
2ТЗ16В, КТЗ16В не более	15 нс
типовое значение	5* нс
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $E_К = 0, I_Э = 10 мА$:	
при $T = 298 К$:	
2ТЗ16А, КТЗ16А	20–60
2ТЗ16Б, КТЗ16Б, 2ТЗ16В, КТЗ16В	40–120
2ТЗ16Г, КТЗ16Г	20–100
2ТЗ16Д, КТЗ16Д	
при $T = 213 К$:	
2ТЗ16А	10–60
2ТЗ16Б, 2ТЗ16В	20–120
2ТЗ16Г	10–100
2ТЗ16Д	30–300
при $T = 398 К$:	
2ТЗ16А	20–120
2ТЗ16Б, 2ТЗ16В	40–240
2ТЗ16Г	20–200
2ТЗ16Д	60–600
Граничное напряжение при $I_Э = 1 мА$ не менее	
типовое значение	5 В
	10* В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_К = 10 мА, I_Б = 1 мА$ не более	
типовое значение	0,4 В
	0,18* В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_К = 10 мА, I_Б = 1 мА$ не более	
типовое значение	1,1 В
	0,8* В
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 10 В$ не более:	
при $T = 298 К$	0,5 мкА
при $T = 398 К$ 2ТЗ16А, 2ТЗ16Б, 2ТЗ16В, 2ТЗ16Г, 2ТЗ16Д	5 мкА
Обратный ток эмиттера при $T = 298 К, U_{ЭБ} = 4 В$ не более	
	1 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5 В$ не более	
типовое значение	3 пФ
	2* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$ не более	
типовое значение	2,5 пФ
	1,2* пФ
Емкость конструктивная между выводами коллектора и эмиттера*	
	0,5 пФ
Индуктивность выводов эмиттера и базы* при $l = 3 мм$.	
	6 нГн

Предельные эксплуатационные данные

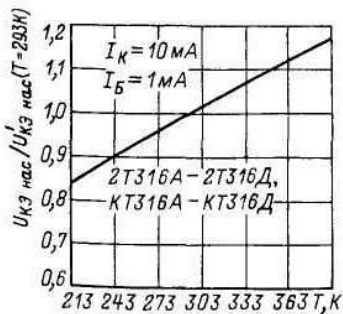
Постоянное напряжение коллектор-база	10 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 3 кОм$	10 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	4 В
Постоянный ток коллектора 2ТЗ16А, 2ТЗ16Б, 2ТЗ16В, 2ТЗ16Г, 2ТЗ16Д	30 мА
Постоянный ток коллектора КТЗ16А, КТЗ16Б, КТЗ16В, КТЗ16Г, КТЗ16Д	50 мА
Постоянный ток эмиттера 2ТЗ16А, 2ТЗ16Б, 2ТЗ16В, 2ТЗ16Г, 2ТЗ16Д	30 мА
Постоянный ток эмиттера КТЗ16А, КТЗ16Б, КТЗ16В, КТЗ16Г, КТЗ16Д	50 мА
Постоянный ток коллектора в режиме насыщения	50 мА
Постоянный ток эмиттера в режиме насыщения	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность	
2ТЗ16А, 2ТЗ16Б, 2ТЗ16В, 2ТЗ16Г, 2ТЗ16Д	
при $T = 213 - 348 К, p > 6650 Па$	150 мВт
при $T = 213 - 348 К, p = 665 Па$	100 мВт
при $T = 398 К$	60 мВт
КТЗ16А, КТЗ16Б, КТЗ16В, КТЗ16Г, КТЗ16Д	
при $T = 213 - 363 К$	150 мВт
при $T = 398 К$	60 мВт
Общее тепловое сопротивление	
Температура перехода	556 К/Вт
Температура окружающей среды	423 К
	От 213 до 398 К



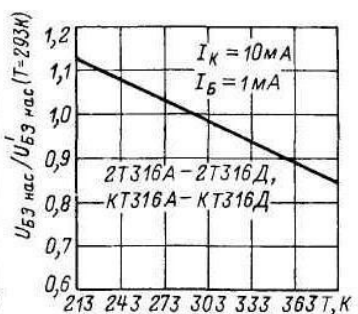
Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером от тока эмиттера



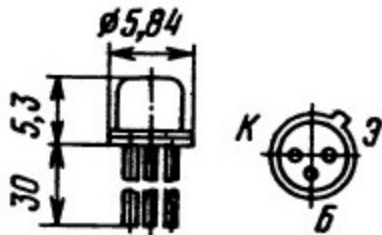
Зависимость относительной граничной частоты от тока эмиттера



Зависимость относительного напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры



Зависимость относительного напряжения насыщения база-эмиттер от температуры

KT316**KT316M**